

Кремниевый фотодетекторный чип 762×762 мкм — техническое описание

P/N : WS9J-10B

Применение

Si NIP фотодиодные чипы.

Структура

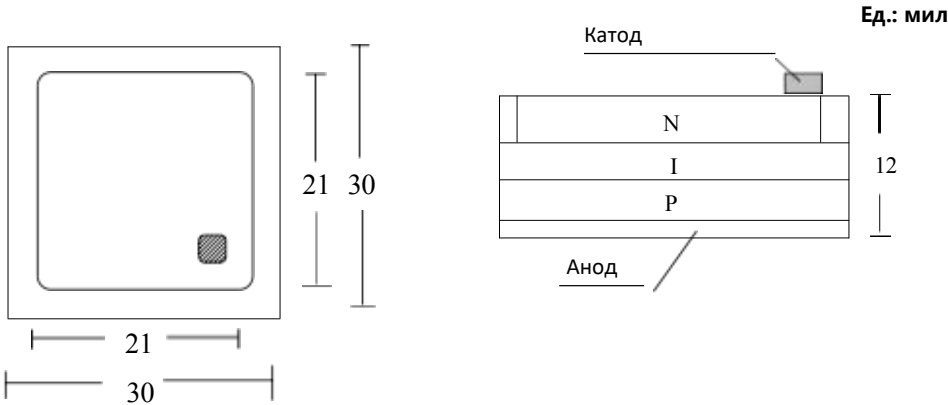
Планарная структура: NIP-диод; электроды: верхняя сторона (катод) — Al, задняя сторона (анод) — сплав Au

ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	21 × 21 (± 1.0)			мил
Ширина чипа	30 × 30 (± 1.5)			мил
Длина чипа	30 × 30 (± 1.5)			мил
Высота чипа	12 (± 1.0)			мил
Контактная площадка катода	4.3 × 4.3			мил
Контактная площадка анода	4.3 × 4.3			мил

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	VF	IF=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	VBR	IR=100μA, H=0	35			В
Обратный темновой ток	ID	VR=10V, H=0			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λр			940		нм
Емкость	CJ	VR=3V, F=1 MHz		9		пФ



WING CHIP

武汉万赢半导体科技有限公司
WUHAN WING CHIP SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY Co.,LTD.

Дистрибьютор в РФ ООО «ПромЭнергоЛаб»

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 1, Тел.: +7 495 677-92-08, 8 (800) 234-12-08, info@czl.ru, www.czl.ru